Rec'd PCT/PTO 20 SEP 2006

特許協力条約

発信人 日本国特許庁(国際調査機関)

代理人

角田 芳末

栊

101-553466 F. 30 12 MAY 225 PCT WIPO

> PCT 国際調査機関の見解書 (法施行規則第40条の2) [PCT規則43の2.1]

あて名

〒160-0023

東京都新宿区西新宿1丁目8番1号

発送日 (日.月.年)

10.05.2005

出願人又は代理人

の告類記号

S05P0179W000

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号

国際出願日 (日.月.年) 08.02.2005 優先日

(日.月.年) 16.02.2004

国際特許分類 (IPC) Int.Cl. H01L25/065, 25/07, 25/18

出願人 (氏名又は名称)

ソニー株式会社

1. この見解書は次の内容を含む。

PCT/JP2005/002196

- ▼ 第 Ⅰ 概 見解の基礎
 - 第Ⅱ概 優先権
- 第Ⅲ棚 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- 第IV概 発明の単一性の欠如
- 第V棚 PCT規則 43 の 2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、 それを裏付けるための文献及び説明
- 第VI樹 ある種の引用文献
- V 第VII棚 国際出願の不備
- 「 第四概 国際出願に対する意見
- 2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国 際予備審査機関がPCT規 66.1 の 2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさ ない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日か ら3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当 な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

15.04.2005

名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員)

4 R 9539

田中 永一

電話番号 03-3581-1101 内線 3469

第1棚 見解の基礎		
1. この見辞書は、	下記に示す	- 場合を除くほか、国際出願の宮語を基礎として作成された。
厂 この見解書に それは国際記	は、 関査のため	語による翻訳文を基礎として作成した。 に提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。
2. この国際出願で 以下に基づき見		>つ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、 及した。
a. タイプ	Γ	配列表
	Г	配列表に関連するテーブル
b. フォーマット	Γ	咨面
	Γ	コンピュータ読み取り可能な形式
c. 提出時期	Г	出願時の国際出願に含まれる
•	Γ	この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された
	Γ	出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された
		E列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出し H した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出が
4. 補足意見:		
	,	

国際調査機関の見解書

第V概	新規性、	進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、
	そわ.を互	「付ろ文献及び説明

1. 見辞

新規性(N)

請求の範囲 2-4

請求の範囲 1

進歩性(IS)

請求の範囲 請求の範囲 1-4

産業上の利用可能性(IA)

請求の範囲 1-4 請求の範囲

2. 文献及び説明

文献1:JP 5-109977 A (三菱電機株式会社) 1993.04.30 文献2:TP 11-168185 A (ローム株式会社) 1999.06.22

文献3:IP 10-200062 A (株式会社ティ・アイ・エフ) 1998.07.31 文献4:JP 2001-156249 A (アジレント・テクノロジーズ・インク)

2001, 06, 08

請求の範囲1に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1から新規性を 有さない。文献1には、ワイヤボンディングパッドと、周辺部の近傍に設けられた外 部端子取り出しのためのパッドと、ワイヤボンディングパッドと配線で接続され中央 部の近傍に設けられた外部端子取り出しのためのパッドとを有するICチップBと、 外部端子取り出しのためのパッドを有するICチップAとを積層した半導体装置が 開示されている。

請求の範囲2に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1より進歩性を有しな い。ICチップにおいてバンプをどの位置に配置するかは設計的事項にすぎない。

請求の範囲3及び4に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1および 文献2より進歩性を有しない。文献2には、ワイヤボンディングに用いられるパッド と、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレーが形成された第1チップ8と、中 央処理ユニットが形成された第2チップ6とを積層した半導体装置が開示されてい る。

国際調査機関の見解書	国際出版番号 PCT/ JP2005/002196
第WIRI 国際出願の不備	
この国際出願の形式又は内容について、次の不備を発見した	。 _引用符号「301(ワイヤ)」が付されてい
FIG. 2において、DRAMの領域に る。	- JIM44 な ・ 9 O T (2 U 1) 1 W411 G4 p C ()
~ ° °	
	•
	•
	•
	,
	·
	,
<u> </u>	
1	
]	•
	•